Mg,Ti 共掺 Al_2O_3 透明多晶陶瓷光谱性能研究*

杨秋红¹[†] 曾智江¹) 徐 军²) 苏良碧²)

1)(上海大学材料科学与工程学院,上海 200072)
2)(中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800)
(2005年7月5日收到,2005年12月4日收到修改稿)

采用传统无压烧结工艺制备 Mg,Ti 共掺透明氧化铝陶瓷,测定了其吸收光谱、荧光光谱和激发光谱,结果表 明,由于 Mg²⁺的电荷补偿,当 Ti 掺入量较小时,Ti 主要以 Tf⁴⁺ 形式存在(Mg,Ti):Al₂O₃ 透明陶瓷只在 250nm 的紫 外波段有吸收峰,为 $O^{2-} \rightarrow Tf^{4+}$ 的电荷转移跃迁产生的吸收,并产生 Tf⁴⁺ 离子在 280—290nm 和 410—420nm 的荧光 发射峰;当 Ti 掺入量较大时,氧化铝透明陶瓷除了存在 Tf⁴⁺ 的吸收峰,还表现出 Tf³⁺离子 490nm 的特征吸收峰,即 ²T₂→²E 跃迁产生的宽带吸收,Tf³⁺离子的发射谱线与 Ti :Al₂O₃ 单晶的相吻合.

关键词:(Mg,Ti):Al₂O₃透明陶瓷,激光陶瓷,光谱性质,电荷补偿 PACC:4262A,7820,8120E,0765

1.引 言

Ti :Al₂O₃ 单晶(钛宝石)具有增益宽、高饱和通 量、大的峰值增益界面、高量子效率、高热导率、高激 光破坏阈值等特点 ,是目前综合性最好、应用最广泛 的可调谐激光材料¹¹ ,是当前国际上公认的最理想 的飞秒超快激光晶体.目前 ,为获得更高功率和强度 的激光器件 ,通常采用钛宝石晶体和掺 Nd 的玻璃 作为混合增益介质 ,可以达到 pW 以至更高的峰值 输出^[2].

但单晶存在生产成本高、生产周期长、光学激活 离子掺杂不均匀等缺点.而陶瓷激光介质研究兴起 及透明陶瓷制备技术的不断发展使陶瓷用于激光介 质成为可能,特别是最近,已制备出散射损耗小、高 透明的多晶 YAG 陶瓷,并且产生了高效的激光振 荡,使得陶瓷激光介质引起人们广泛关注^[3].陶瓷相 对于单晶激光介质有以下优点:成本低、生产效率 高、可以制造大尺寸和形状复杂的样品、激活离子掺 杂浓度高等^[4].迄今为止,把 Al₂O₃ 陶瓷作为激光介 质来研究的,有 Murotani 等^[4]、曾智江等^[5]和杨秋红 等^[6],他们分别对掺 Cr 和掺 Ti 的 Al₂O₃ 陶瓷进行了 光谱分析. 近来,研究人员开始关注 T_{1}^{4+} 离子在氧化物单 晶体的光谱性能^{7-9]}. T_{1}^{4+} 具有紧密壳层电子构型 ($3d^{0}$),当 T_{1}^{4+} 掺入氧化物晶体时,唯一的电子跃迁 就是氧化物 $\longrightarrow T_{1}^{4+}$ 的电荷转移跃迁(CT). 其吸收 和发射分别位于紫外和蓝光谱区.对 T_{1}^{4+} :Li₄Ge₅O₁₂ 的研究显示,在蓝光到绿光波段它是一种潜在的可 调谐固体激光材料^[8],可以获得从 388nm 到 524nm 的光学增益^[9].

本文通过 Mg²⁺的电荷补偿,对 Ti⁴⁺离子在氧化 铝透明陶瓷的吸收光谱、荧光光谱和激发光谱进行 了初步研究.

2. 实验过程

本实验采用传统陶瓷烧结工艺制备 Mg, Ti 共掺 氧化铝透明陶瓷.采用高纯的 α -Al₂O₃(99.95%)和 MgO(99.95%), TiO₂(99.99%)为原料, MgO 掺杂量 为 0.1wt%,激活离子 TiO₂ 掺杂量分别为 0.05wt%, 0.1wt%, 0.2wt%, 0.4wt%,并依次标号为 T1, T2, T3, T4.混合料在球磨罐中球磨 24h,出料并烘干,用冷 等静压在 200MPa 的压力下制成直径为 25mm,厚度 为 10—20mm 的圆片,然后在 1700—1750℃下氢气 氛中烧结 1—15h.烧结好的样品进行切割、粗磨、细

^{*}国家自然科学基金(批准号 160578041)资助的课题.

[†] E-mail : yangqiuhongen@yahoo.com.en

磨和双面镜面抛光,厚度为1mm,采用日本JASCO 公司的 V-570型 UV/VIS/NIR 分光光度计及JASCO 公司的 FP-6500/6600 分光荧光计分别测定了氧化铝 透明陶瓷样品的吸收光谱和荧光光谱.分光光度计 测试波长范围为190—2500nm,分光荧光计的抽运 源为150W的 Xe 灯和488nm的氩离子激光器,样品 的荧光光谱和激发光谱分辨率均为1—2nm.

3. 结果与讨论

 Ti^{4+} 的电子组态为 $1s^22s^22p^63s^23p^63d^9$,其外壳层 没有未配对的 3d 电子,由此决定了其唯一的电子跃 迁就是氧化物 $\leftarrow \rightarrow Ti^{4+}$ 的电荷转移跃迁(CT) 9^{91} .其 吸收和发射分别位于紫外和蓝光谱区.

Mg ,Ti 共掺氧化铝透明陶瓷照片如图 1 所示 , 具有良好的透光性。

图 2 为 Mg, Ti 共掺氧化铝透明陶瓷的室温吸收 光谱.当 Ti 含量少时,如图 2(a)所示,只在约 250nm 处有吸收,而没有测出 Ti³⁺离子在 490nm 的吸收峰.



图 1 透明氧化铝陶瓷 T1 照片

根据 Bausa 等人^[10]光谱测试结果 ,250nm 处吸收是 由 O²⁻→Ti⁴⁺ 的电荷转移跃迁产生的吸收 ;当掺 Ti 量多时 除了有 250nm 处的吸收外 还测出 Ti³⁺离子 在 490nm 特征吸收峰 ,即²T₂→²E 跃迁产生的宽带吸 收 ,如图 2(b)所示.由于大气对紫外光有较强烈的 吸收 ,低于 250nm 波长的光易被空气吸收.为了进一 步证实 Ti⁴⁺在 250nm 左右的吸收 ,我们做了激发光 谱测试.



图 2 Mg, Ti :Al₂O₃ 透明陶瓷的室温吸收光谱 (a)T1 和 T2 样品; (b)T4 样品



图 3 Mg ,Ti :Al₂O₃ 透明陶瓷的室温荧光光谱和激发光谱 (a)T1 样品 ;(b)T2 样品

图 3(a)和(b)分别为 Ti 含量较少时的 Mg,Ti: Al₂O₃ 透明陶瓷样品 T1 和 T2 在室温下的荧光光谱 和激发光谱.由图 3(a)可知,采用 250nm 的抽运光, T1 样品的发射峰在 290nm 和 410nm;对 410nm 的发 射峰进行激发,其激发峰位于 250nm;采用 227nm 的 抽运光,T2 样品的发射峰在 280nm 和 420nm.对 280nm 的发射峰进行激发,其激发谱峰位于 230nm 处,如图 3(b)所示.说明无论是 410—420nm 左右的 发射峰,还是 280—290nm 左右的发射峰,其吸收峰 都位于 230—250nm 范围,是 Ti⁴⁺离子的电荷转移跃 迁吸收峰.

图 4 为掺 Ti 量较多的 Mg ,Ti 共掺氧化铝透明 陶瓷的室温荧光光谱.由图可知 ,T3 ,T4 陶瓷样品中 有 Ti³⁺ 离子的发射谱线 ,与钛宝石单晶的发射谱线 相吻合^[1].由于 Mg²⁺ 含量较少 ,只能对部分 Ti⁴⁺ 起 到电荷补偿 ,在还原气氛下 ,多余的 Ti⁴⁺ 将被还原为 Ti³⁺ ,因此在 Ti 含量较多的 Mg ,Ti 共掺氧化铝透明 陶瓷中 ,同时存在 Ti⁴⁺ 和 Ti³⁺ 离子.



图 4 Mg ,Ti :Al₂O₃ 透明陶瓷 T3 ,T4 的室温荧光光谱

Powell 等¹¹¹和 Yamaga 等¹²¹人的研究表明, 410nm 荧光的发光中心是孤立的 Ti⁴⁺ 离子. Ti :Al₂O₃ 晶体在氧化气氛中热处理,随着晶体中 Ti³⁺ 离子的 氧化,由于 O²⁻ 离子的间隙位形成能很高,Al³⁺ 空位 将是主要的电荷补偿途径¹³¹. 另外,由于 O²⁻ 空位的 形成能很低,所以电中性条件可以表述为 Yamaga^[12]等人在氧化气氛中生长,并且没有进 行 H₂ 气氛退火处理的 Ti :Al₂O₃ 单晶样品表现出 Ti⁴⁺离子发光,而经过 H₂ 气氛退火处理的单晶样品 则没有 Ti⁴⁺离子发光.而本文的样品是在 H₂ 气氛下 烧结,其在荧光光谱中仍有 410nm 的 Ti⁴⁺离子发光. 这主要是因为陶瓷中加入了 MgO ,MgO 的存在产生 了 O^{2-} 空位:

$$2MgO \xrightarrow{Al_2O_3} 2Mg'_{Al} + V_{\ddot{0}} + 2O_0 , \qquad (2)$$

O²⁻ 空位使得 Ti⁴⁺ 离子稳定存在,并产生 410nm 的荧 光发射.因此 Mg²⁺ 在 Ti 掺杂的 Al₂O₃ 透明陶瓷中对 Ti⁴⁺ 起到电荷补偿的作用.T1 和 T2 样品因其 Ti 含 量较小,只在约 250nm 处存在 Ti⁴⁺ 离子的电荷转移 跃迁吸收和在 280—290nm 及 410—420nm 处存在 Ti⁴⁺ 离子的荧光峰.

Macke 等^[14]和 Blasse 等^[15]研究发现掺 Ti⁴⁺离子 的锡酸盐及锆酸盐中广泛存在两个荧光带,即蓝带 和黄带,认为这两个发光带是由处于规则的钛酸盐 八面体和缺陷钛酸盐八面体中 TiO₆上的电荷转移 跃迁产生的.分子轨道理论所给出的反键轨道如 t_{lu} (σ^* , π^*)等为这些配位体 O²⁻离子和中心离子 Ti⁴⁺间转换的电荷提供了跃迁的能级近都还不清楚, 有待进一步更深入的研究探讨.

4. 结 论

Mg,Ti 共掺氧化铝透明陶瓷,当 Ti 含量较小时, 由于 Mg²⁺ 的电荷补偿,使得 Ti 主要以 Ti⁴⁺ 形式存 在 ,Al₂O₃ 陶瓷吸收光谱中只有 250nm 的吸收峰,为 O^{2-} →Ti⁴⁺ 的电荷转移跃迁吸收,并产生 280—290nm 和 410—420nm 的 Ti⁴⁺ 离子荧光发射;当 Ti 含量较 大时 ,氧化铝透明陶瓷除了存在 250nm 处 Ti⁴⁺ 的电荷 转移跃迁吸收峰外 还表现出 Ti³⁺ 离子的 490nm 特征 吸收峰,即²T₂→²E 跃迁产生的宽带吸收 ;Ti³⁺ 离子的 发射谱线与 Ti :Al₂O₃ 单晶的发射谱线相吻合.

- [1] Moulton P F 1986 J. Opt. Soc. Am. **B 3** 125
- [2] Perry M D , Pennington D , Stuart B C et al 1999 Opt . Lett . 24 160
- [3] Lu J , Prabhu M , Song J et al 2000 Appl . Phys. B 71 469
- [4] Murotani H, Mituda T, Wakaki M et al 2000 Jpn. J. Appl. Phy. 39 2748
- [5] Zeng Z J , Yang Q H , Xu J 2005 Acta Phys. Sin. 54 5445 (in

Chinese)[曾智江、杨秋红、徐 军 2005 物理学报 54 5445]

- [6] Yang Q H, Zeng Z J, Xu J, Su L B 2005 J. Synthetic Crystals 34 856 (in Chinese)[杨秋红、曾智江、徐 军、苏良碧 2005 人工 晶体学报 34 856]
- [7] Blasse G 1980 Structure and Bonding, Luminescence and Energy Transfer 42 1 (Beijing : Springer)
- [8] Loiacono G M, Shone M F, Mizell G et al 1986 Appl. Phys. Lett. 48 622
- [9] Wong W C , Danger T , Huber G et al 1997 J. Lumin . 72 208

- [10] Bausa L E , Vergara I , Jaque F et al 1990 J. Phys. : Condens. Matter , 2 9919
- [11] Powell R C , Caslavsky J L , Bowen J M et al 1985 J. Appl. Phys. 58 2331
- [12] Yamaga M , Yosida T , Hara S et al 1994 J. Appl. Phys. 75 1111
- [13] Mohapatra S K , Kroger F A 1977 J. Amer. Ceram. Soc. 60 381
- [14] Macke A J H 1976 J. Solid. State Chemistry 18 337
- [15] Blasse G 1968 Phlisps. Res. Reps. 23 344
- [16] Tippins H H 1970 Phys. Rev. B 1 126

Spectroscopic characteristics of transparent polycrystalline MgO and TiO₂ codoped Al₂O₃ ceramics *

Yang Qiu-Hong¹[†] Zeng Zhi-Jiang¹) Xu Jun²) Su Liang-Bi²

1) School of Materials Science and Engineering , Shanghai University , Shanghai 200072 , China)

2) Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China)

(Received 5 July 2005; revised manuscript received 4 December 2005)

Abstract

Transparent polycrystalline MgO and TiO₂ codoped Al₂O₃ ceramics were fabricated by conventional solid-state pressureless processing. The absorption , emission and excitation spectra of (Mg ,Ti):Al₂O₃ ceramics were measured. Owing to charge compensation of Mg²⁺ , only UV absorption around 250nm was observed due to $O^{2-} \rightarrow Ti^{4+}$ charge transfer transitions (CT) when Ti content was low. As a result , the emission peaks of isolated Ti⁴⁺ ion located at 280—290nm and 410—420nm were observed. Besides absorption peak of Ti⁴⁺ ion , the characteristic absorption peak of Ti³⁺ ion centered at 490nm was observed in (Mg ,Ti):Al₂O₃ ceramics when Ti content was high. The emission spectra of Ti³⁺ ion in polycrystalline Al₂O₃ ceramics coincide with that of Ti :Al₂O₃ single crystal.

Keywords : transparent (Mg ,Ti) : Al₂O₃ ceramics , laser ceramics , spectroscopic characteristics , charge compensation **PACC** : 4262A , 7820 , 8120E , 0765

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60578041).

[†] E-mail :yangqiuhongen@yahoo.com.en